Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0214U006882

Державний реєстраційний номер: 0108U004836

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 03-03-2014

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розроблення методики лазерно-індукованого легування високоомних кристалів CdTe індієм і визначення оптимальних умов та режимів для формування сильнолегованого поверхневого шару n-типу. Встановлення фізичних механізмів індукованого легування і створення моделей процесів, що відбуваються при цьому. Розроблення технічних вимог до лазерної технології легування

Початок етапу: 01.2008

Закінчення етапу: 12.2008

Вид звітного документа: Проміжний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Президія Національної академії наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380 44 525-40-20 , 380 44 525-83-42

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442396594

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування: 2.3 - виконання робіт за державними цільовими програмами

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6541030

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 140

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розроблення і створення матриць сенсорних діодних структур та приладу для детектування ядерного випромінювання

Назва роботи англійською:

Development and creation of sensor diode structure arrays and device for nuclear radiation detection

Реферат українською:

Розроблення методики лазерно-індукованого легування високоомних кристалів CdTe індієм і визначення оптимальних умов та режимів для формування сильнолегованого поверхневого шару n-типу.

Реферат англійською:

Development of techniques of laser-induced doping of CdTe crystals of high-indium and determine the optimal conditions and modes to form the surface layer of heavily doped n-type.

Індекс УДК: 537.311.322, 621.386.82; 535.21

Коди тематичних рубрик: 29.19.31

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Власенко Олександр Іванович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

1. V.A. Gnatyuk, O.I. Vlasenko, L.A. Kosyachenko, O.L. Maslyanchuk, V.M. Sklyarchuk, E.V. Grushko, T. Aoki, CdTe-based Schottky diode X-ray detectors for medical imaging, The Eighth International Conference Correlation Optics. Proceed. of SPIE, Vol. 7008 (April, 2008) 70081Z-1-10. 2. L.A. Kosyachenko, O.L. Maslyanchuk, V.A. Gnatyuk, C. Lambropoulos, I.M. Rarenko, V.M. Sklyarchuk, O.F. Sklyarchuk, Z.I. Zakharuk, Charge collection properties of a CdTe Schottky diode for x- and ?-rays detectors, Semiconductor Science and Technology, Vol. 23, No 7 (2008) 075024-1-8.

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Мачулін Володимир Федорович

Перелік осіб-виконавців

Велещук В.П.

Власенко З.К.

Гнатюк В. А.

Левицький С.М.

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

